



제25회 한국반도체학술대회

The 25th Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 7일(수), 16:15-17:30

Room D (함백II+III, 5층)

E. Compound Semiconductors 분과

[WD4-E] SiC Device

좌장: 차호영 교수(홍익대학교)

<p>WD4-E-1 16:15-16:30</p>	<p>Low Frequency Noise in SiC Double-Implant MOSFETs Sangwon Baek, Iksoo Park, Rockhyun Baek, and Jeong-soo Lee <i>Department of Electrical Engineering, POSTECH</i></p>
<p>WD4-E-2 16:30-16:45</p>	<p>1.2 kV 급4H-SiC 쇼트키장벽 다이오드의 전기적 특성 최적화를 위한 에피층 및 접합중단구조 설계 박힘찬^{1,2}, 한상보¹, 방욱², 김동영³, 이현수³, 금주연⁴, 강인호² ¹경남대학교 첨단공학과, ²한국전기연구원 전력반도체연구센터, ³경상대학교 반도체공학과, ⁴창원대학교 신소재융합공학과</p>
<p>WD4-E-3 16:45-17:00</p>	<p>5kV 급 4H-SiC 쇼트키 접합 다이오드의 전기적 특성 및 소재 분석 금주연^{1,2}, 나문경², 강인호², 방욱², 구분훈¹ ¹창원대학교 신소재융합공학과, ²한국전기연구원 전력반도체연구센터</p>
<p>WD4-E-4 17:00-17:15</p>	<p>High Current Density and High Breakdown Voltage of 4H-SiC Trench MPS Applying JTE Structure 김동영^{1,2}, 석오균², 방욱², 김형우², 박기철¹ ¹경상대학교 반도체 공학과, ²한국전기연구원 전력반도체연구센터</p>
<p>WD4-E-5 17:15-17:30</p>	<p>Analysis of 4H-SiC Fin-Type VDMOSFET for Low on-Resistance Dongwoo Bae, Doohyung Cho, and Kwangsoo Kim <i>Department of Electronic Engineering, Sogang University</i></p>